### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

59-205434

(43) Date of publication of application: 21.11.1984

(51) Int. CI.

C22C 5/04

B01D 13/00

B01D 53/22

(21) Application number: 58-077425 (71) Applicant: HITACHI LTD

(22) Date of filing:

04.05.1983 (72) Inventor: SAKAMOTO YOSHIICHI

TAKAYAMA SHINJI SHINGUU HIDEO

# (54) PD BASE AMORPHOUS ALLOY FOR HYDROGEN SEPARATING AND REFINING MEMBRANE MATERIAL (57) Abstract:

PURPOSE: To provide the titled alloy having excellent properties wherein hydrogen permeability is high and the generation of a  $\beta$  hydride phase is not recognized, by containing Si in a Pd base alloy such as Pd-Ag to make the same amorphous.

CONSTITUTION: An alloy consisting of, on an atomic % basis, 9W30% of Si, 20% or less of X (one or more of Ag, Au, Cu, Ni and/or Fe) and the remainder of Pd is processed by an ultra-quenching method to obtain an amorphous Pd-Si-X alloy foil. This alloy foil is high in hydrogen permeability and generates no deterioration in material quality with the formation and disappearance of an  $\alpha$ -phase/ $\beta$ -phase hydride phase as absorved in a crystalline Pd-alloy.

Copyright (C); 1998, 2003 Japan Patent Office

# (1) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

# ⑫ 公開特許公報 (A)

昭59—205434

MInt. Cl.3

識別記号

广内整理番号 7730-4K 43公開 昭和59年(1984)11月21日

C 22 C 5/04 B 01 D 13/00 53/22 B 7305-4D A 7917-4D

発明の数 審査請求 未請求

(全 3 頁)

図水素の分離・精製薄膜材料用 Pd基非晶質合 金

@特

顧 昭58-77425

20出

願 昭58(1983)5月4日

の発 明

者 坂本芳一

長崎市錦町741-4

個発 明者 髙山新司

国分寺市東恋ケ窪1丁目280番

地株式会社日立製作所中史研究 所内

明者 新宮秀夫 @発

京都市左京区松ケ崎小脇町28

願 人 株式会社日立製作所 **创出** 

東京都千代田区神田駿河台4丁

目6番地

四代 理 人 弁理士 髙橋明夫

外1名

発明の名称 水素の分離・精製薄膜材料用 P d 基非晶質合金

#### 特許請求の範囲

原子がでSi 9~30%、Ag, Au, Cu, Ni, Feの中から選ばれる何れか1種以上を20 多以下、残部実質的にPdからなる水素の分離・ 精製薄膜材料用Pd 基非晶質合金。

#### 発明の詳細な説明

#### [発明の利用分野]

本発明は水紫と水紫以外の気体を含んだ混合ガ ス中の水素の分離および水素精製薄膜用材料に関 するものである。

## (発明の背景)

従来、との種の材料は結晶質のPd あるいは Pd<sub>77</sub> Ag<sub>23</sub> 合金などのPd 基合金が使用されて いる。しかしながら、とれらの合金は室温附近の 低温度においては、特に繰返えし水素の吸蔵、放 出によるα相/β水素化物相の生成。消失に伴な つて材質の靱性を箸しく害する欠点があり、水素

混合ガス中の水素の分離、精製装置の設計上障害 となつている。

### 〔発明の目的〕

本発明の目的は水素の透過能が大きく、かつβ 水索化物相の析出に伴なり材質の変形および破損 に対して優れた性質を有するPd-Si-X(X =A8, Au, Cu, Niおよび/もしくはFe). 系非晶質合金箔を提供することにある。

#### [発明の紙要]

本発明は原子まで8iが9~30パーセント、 X (X=Ag, Au, Cu, Ni, Feからなる 群より選択された少なくとも1元素)が20%以 下、残部実質的にPdからなる合金組成で、超急 冷法によつて得た非晶質合金であり、結晶質 P d 合金に見られるようなβ水素化物相を析出しない 安定な構造の非晶質 Pd-Si-X系合金箔であ

次に上記成分の限定理由について説明する。Si は非晶質組織の形成に最も有効な元素であり、通 常9~30%が最適であるので上配の彡に限定す る。 X (X=Ag, Au, Cu, Ni および/もしくはFe) の添加は合金の触点を低下させ、非晶化を促進し、熱安定性を高める効果がある。しかし20%を越えると非晶質形成能が逆に悪くなる傾向にあり、水素の透過能も減少する傾向があるので X の含有量は 20%以下に限定する。 〔発明の実施例〕

次に本発明の実施例を示す。本発明の効果を実証するために実験した本発明合金試料 6 種類の合金組成を以下に示す。

- (1) Pds2 Si 18 . (2) Pd78 Si 18 Au4.
- (3) Pd73.8 Sia Ag2.2 (4) Pd73.8 Sia Cu2.2
- (5) Pd73.8 Si 18 Ni 8.2 (6) Pd73.8 Si 18 Fe 8.2 試料はいずれもアルゴン雰囲気中で上記組成の母 合金を作製後、その母合金20g F を用いて高周 波加熱で溶験し、大気中片ロール法(ロール径 3 0 0 mmの銅ロールで回転数 1 2 0 0 rpm) による 超急合で作製した厚さ 2 5 ~ 3 5 μm、幅約 1 1 mmのリポン状非晶質試片である。なお、結晶化温 度は組成によつてやや異なるが 3 9 0 ~ 4 3 5 で

は J - / i · = 0.85 ~ 0.96 の範囲にあり、 Pd • 2 Si 1 • および Pd 7 • Si 1 • Au 4 合金など他の非晶質合金では J - / i · = 0.55 ~ 0.74 の範囲であつた。

第2図には水素吸蔵により、β水素化物相など 異相の生成あるいは結晶化などが生ずるか否かを 調べるためにPds2SissおよびPd78SisAu4合 金について水素吸蔵前後のX線回折線図を調べた 結果を示す。ととで使用した対陰極はCuKa級、 フイルターはNiである。水素吸蔵によつて2β ≃ 4 0 π / 1 8 0 rad における非晶質合金に特有 のハローピーク位置はわずかに低回折角側に移動 するが結晶質のP d 合金で観察されているような β水素化物相の主成は認められず、さらに結晶化 も生じていないことがわかつた。上述のハロー・ ピーク位置の低回折角側への移動からもわかるよ りに、特に高陰極電流密度で、長時間、水素吸蔵 するとその吸蔵面は水紫の侵入、吸蔵によつて弾 性的に弓状に彎曲することが観察された。しかし 吸蔵後、室温に数時間放置すると水素の放出とと

である。

水素の透過能の評価は電気化学的透過法で測定した水素透過曲線を解析して得た水素の拡散係数(D) かよび試片の陰極表面直下の水素濃度(C) を用いて定常状態の透過電流密度(J==FDCL<sup>-1</sup>)を算出して行なつた。ととでF=ファラデー定数、L=試片の厚さで、L=30 mに規格化した。測定条件は陰極液:032NH2SO4+25mg/LH2SeO3溶液、陽極液:0.1NNaOH溶液、陽極設定電位;0mVvs.SCE、測定温度;6~64℃、である。

もに再び速かに元に戻る。したがつて非晶質 P d ー S i ー X 系合金は水素吸蔵に対して高い靱性を保持しており、また水素の吸蔵放出過程は結晶質 P d 合金に比較して、より可逆的であることがわかつた。

## 〔発明の効果〕

以上に説明するように本発明によれば水素の透過能が大きく、かつ従来の結晶質Pd合金に見られるように α相/β水素化物相の生成、消失に伴なう材質の劣化を生ずることのない非晶質Pdー SiーX系合金箔を水素以外の気体を含有する水素混合ガス中の水素の分離、精製効果を増大させ、使用することはその分離、精製効果を増大させ、かつ経済的にも有益である。さらに本発明のPdー SiーX系非晶質合金箔は安価なSiを多量に含むため従来の結晶質Pd合金と比べて原料費を大巾に下げることが出来る利点がある。

なか本発明によれば非晶質 P d - S i - X系合金における添加元素 X は A g . A u . C u . N i . F c に限るものでなく、例えば P t . R b . R u .

# 特萬昭59-205434 (3)

C r . M n . G e . C o 等容易に、かつ安定な非晶質組織が得られる元素およびその添加量をも包合して添加元素 X と考えることもできる。 図面の簡単な説明

第1図は非晶質 P d - S i - X系合金中の水素の定常状態の透過電流密度と陰極電流密度との関係を示すグラフ、第2図は水素吸蔵前後のX線回折線図を示す図である。

代理人 弁理士 高橋明夫



